



SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA

FORMULÁRIO PARA A REPRODUÇÃO DE RESUMO DE TRABALHO

Informar se o trabalho será apresentado em Sessão de

- ☒ Painéis
☐ Comunicação Oral

Informar que equipamento audiovisual irá necessitar

- ☐ Projetor de slides
☐ Retroprojektor

(para uso da Secretaria)

IMPORTANTE Leia todas as INSTRUÇÕES antes de datilografar o RESUMO.

MOBILIDADE HALL E CONCENTRAÇÃO DE PORTADORES EM FILMES SEMICONDUTORES GaAs:Si CRESCIDOS POR MBE - A.M. Ceschin, A.C. Notari, E. Manzoli, B. Sharappe e M. Siu Li - Instituto de Física e Química de São Carlos - USP.

Filmes semicondutores de GaAs:SI / GaAs foram crescidos por epitaxia por feixe molecular (MBE), com espessuras de 1 a 2 μ . Medidas de efeito Hall e condutividade elétrica indicaram a presença de concentração de portadores na faixa de 10^{18} a 10^{15} cm^{-3} . Isto foi conseguido variando-se apenas a temperatura da célula de efusão do Si (1300° - 1000°C), com a temperatura do substrato mantida a 600°C . Uma das amostras apresenta concentração de portadores de 10^{18} cm^{-3} e uma mobilidade de $1500 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ à temperatura de 77 K. Acompanhando a morfologia da amostra e estes resultados, mostramos a viabilidade de nosso sistema de MBE.

41a. Reunião Anual
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

D.1.4.

Indique letra e número da
Seção (consulte instruções)

41a. Reunião Anual
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

D.1.4

Indique letra e número da
Seção (consulte instruções)

COMPROVANTE DE ACEITAÇÃO DE RESUMO

Artemis M. Ceschin, Airton C. Notari, Eduardo Manzoli,
Autor(es) — nome por extenso
Bruno Sharappe e Máximo Siu Li

Título do trabalho Mobilidade Hall e concentração de portadores
em filmes semicondutores GaAs:Si crescidos por MBE

Secretaria da SBPC

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE RESUMO

Artemis M. Ceschin, Airton C. Notari, Eduardo Manzoli,
Autor(es) — nome por extenso
Bruno Sharappe e Máximo Siu Li

Título do trabalho Mobilidade Hall e concentração de portadores
em filmes semicondutores GaAs:Si crescidos por MBE

Secretaria da SBPC

Ciência e Cultura. Supl., 41 (7): 285, jul. 1989

00001139

Campo	Dado
*****	Documento 1 de 1
No. Registro	000791741
Tipo de material	TRABALHO DE EVENTO-RESUMO PERIODICO - NACIONAL
Entrada Principal	Ceschin, A M (*)
Título	Mobilidade hall e concentracao de portadores em filmes semicondutores 'GA"AS' : 'SI' crescidos por mbe.
Imprensa	São Paulo, 1989.
Descrição	p.285.
Autor Secundário	Notari, A C (*)
Autor Secundário	Manzoli, E (*)
Autor Secundário	Sharappe, B (*)
Autor Secundário	Siu Li, Máximo
Autor Secundário	Reunião Anual da SBPC (41. 1989 Fortaleza)
Fonte	Ciência e Cultura, São Paulo, v.41, n.7 supl., p.285, jul. 1989
Unidade USP	IFQSC-F -- INST DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
Localização	IFSC PROD001139